

полупроводника, что вызывает периодическое изменение индуктивности катушки, параметрическую раскачку резонансного контура, образованного индуктивностью катушки и ее собственной емкостью, и появление выходного напряжения также и при магнитном поле, близком к нулю.

Таким образом, в настоящей работе впервые продемонстрирован диамагнетизм неравновесной плазмы твердого тела, вызванный воздействием светового излучения. Обнаруженный эффект может быть использован для преобразования электромагнитного излучения в электрический сигнал.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Франк - Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. М.: Атомиздат, 1964.

Поступило в Редакцию
6 февраля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 12 26 июня 1990 г.

0.4

© 1990

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИОНЫ В ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ПЛАЗМЕ ГЕКСАФТОРИДА СЕРЫ

Н.Г. Немцева, А.М. Пржонский

Низкотемпературная плазма в электроотрицательных газах, включая SF_6 , находит широкое применение в различных научных и технических устройствах [1, 2]. Этим обусловлена необходимость всестороннего исследования ее физико-химических свойств, в частности, формирования нейтрального и ионного состава [3, 4]. Нами предпринята попытка масс-спектрометрического измерения состава положительных и отрицательных ионов в разрядной плазме в SF_6 , сведения о котором весьма ограничены [4]. Одновременно определялась также степень разложения SF_6 в разряде, а с помощью электрических зондов измерялись их вольт-амперные характеристики и определялись величины продольного поля E . Аппаратура и методика эксперимента в основном аналогичны описанным ранее [5-7]. Имелись при этом определенные трудности, связанные, как с неустойчивостью разряда постоянного тока в электроотрицательном газе [7], так и с большими величинами продольного электрического поля E , достигающего $50 \text{ В} \cdot \text{см}^{-1}$ и более. В отличие от [4], где аналогичные измерения выполнены в плазме ВЧ разряда в алю-

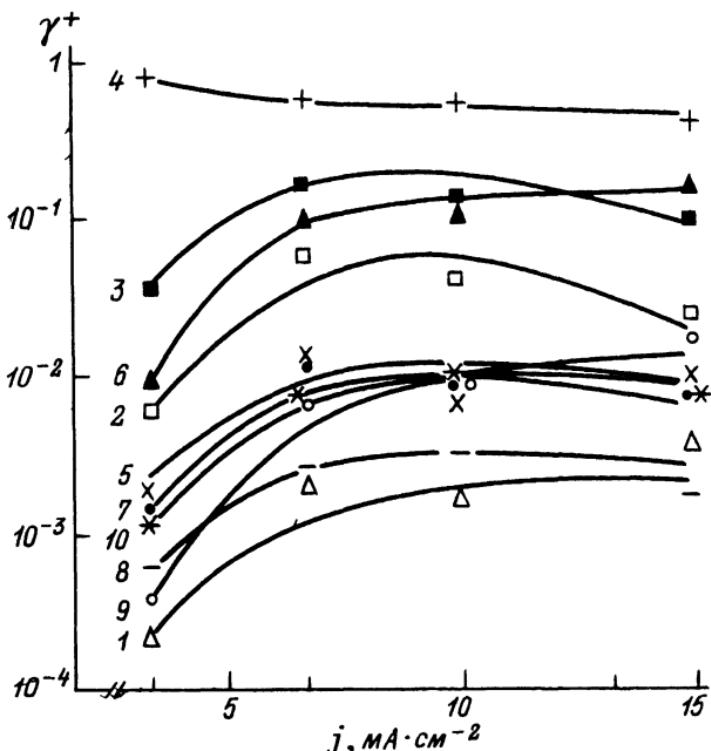


Рис. 1. Состав потока положительных ионов в зависимости от плотности разрядного тока ($P = 40$ Па): 1 - F^+ , 2 - SF^+ , 3 - SF_2^+ , 4 - SF_3^+ , 5 - SF_4^+ , 6 - SF_5^+ , 7 - $(S^+ + O_2^+)$; 8 - SO^+ , 9 - $-SO_2^+$, 10 - $(SiF_3^+ + SOF_2^+)$; $\gamma^+ = \frac{J_i^+}{\sum_i J_i^+}$ (J_i^+ - ток i - компоненты положительных ионов).

миниевой камере (с кремниевым образцом и без него), в нашем случае плазма создавалась разрядом постоянного тока в цилиндрической трубке ($R = 1$ см) из молибденового стекла (основной компонент в нем SiO_2).

Нами была идентифицирована большая серия положительных (рис. 1) и отрицательных (рис. 2) ионов. Результаты представлены в виде зависимостей относительных величин токов соответствующих ионов на выходе масс-анализатора от плотности разрядного тока $j = 3.5-15$ $mA \cdot cm^{-2}$ (давление газа $P = 40$ Па). Здесь же отметим, что из наших измерений нейтрального состава вытекает величина степени разложения SF_6 при $j = 15$ $mA \cdot cm^{-2}$ и $P = 40$ Па равная почти 50 %. Для сопоставимости данных рис. 1 и 2 укажем, что, например, при $j = 10$ $mA \cdot cm^{-2}$ токи ионов SO_2^+ и F^- приблизительно одинаковы.

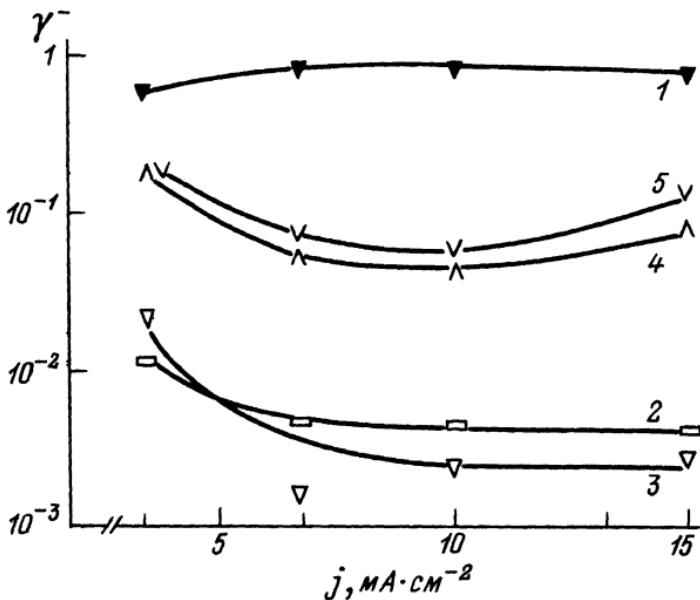
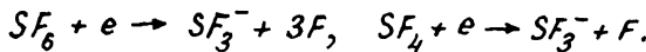
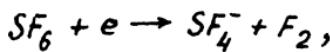
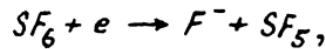
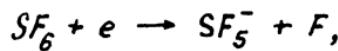


Рис. 2. Состав потока отрицательных ионов в зависимости от плотности разрядного тока ($P = 40$ Па): 1 - F^- , 2 - SF_3^- , 3 - SF_4^- ,

4 - SF_5^- , 5 - SF_6^- ; $\gamma = \frac{J_i^-}{\sum_i J_i^-}$ (J_i^- - ток i - компоненты отрицательных ионов).

Образование в плазме ионов F^+ , S^+ и SF_n^+ , $n = 1-5$ связано, как отмечено в [4], с электронной ионизацией (в том числе диссоциативной) молекул SF_6 и ее фрагментов. Появление же ионов SO^+ , SO_2^+ , SOF^+ , SiF_3^+ обусловлено травлением стеклянных стек (SiO_2) атомами фтора, образующимися при разложении в ряде исходных молекул; выделяющийся при этом в объеме (в результате реакции $SiO_2 + 4F \rightarrow SiF_4 + O_2$) молекулярный кислород окисляет SF_6 и ее фрагменты подобно тому, как это происходит в плазме CF_4 [1, 7].

Наиболее интересной особенностью исследуемой плазмы оказалось образование пяти видов отрицательных ионов, обусловленное электроотрицательностью молекулы SF_6 и ее осколков [8, 9]. В отличие от [4], где наблюдалась ионы F^- , SF_3^- и SF_5^- нами дополнительно обнаружены SF_4^- и SF_6^- . Образование всех этих отрицательных ионов (кроме SF_6^-) должно быть связано по нашим оценкам в основном с ниже приведенными реакциями диссоциативного присоединения электронов к молекулам:



Появление SF_6^- может происходить также в результате парного столкновения молекулы и электрона с той лишь разницей, что образуется долгоживущий отрицательный комплекс с временем жизни $\tau \geq 10^{-5}$ с [10]: $SF_6 + e + SF_6^- \rightarrow SF_6^- + M$ (затем $SF_6^- + M \rightarrow SF_6^- + M(\epsilon)$), где M – любая молекула, например, SF_6 , SF_5 .

Приведенные на рисунках данные, по-видимому, достаточно хорошо (с точностью до величин подвижности ионов) отражают соотношения между плотностями положительных и отрицательных ионов в пристеночной области плазмы. Что же касается приосевой зоны, то оценить в ней эти соотношения будет, вероятно, возможно на основе недавно опубликованной работы [11], где изложены основы теории положительного столба разряда в электроотрицательном газе. Из [11], в частности, следует, что радиальные профили концентрации отрицательных ионов в газоразрядной трубке сильно зависят от конкретных условий, т.е. от соответствующих им величин таких важных параметров, как коэффициенты прилипания и отлипания электронов, диффузии и рекомбинации отрицательных ионов. В то же время совершенно очевидно, что именно форма радиального профиля определяет в основном величину тока этих ионов на диафрагму (разумеется, при ее потенциале, близком или несколько выше потенциала пристеночной плазмы).

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Словецкий Д.И., Дерюгин А.А. В кн.: Химия плазмы. Вып. 13/Под ред. Б.М. Смирнова. М.: Энергоатомиздат, 1986. С. 240–277.
- [2] Данилин Б.С., Киреев В.Ю. Применение низкотемпературной плазмы для травления и очистки материалов. М.: Энергоатомиздат, 1987. 263 с.
- [3] Wagner J.J., Brandt W.W. // Plasma Chem. Plasma Processing. 1981. V. 1. N 2. P. 201–215.
- [4] Picard A., Turban G., Groilleau B. // J. Phys. D., Appl. Phys. 1986. V. 19. N 6. P. 991–1005.

- [5] Пржонский А.М. // Укр. физ. журн. 1977. Т. 22. № 12. С. 2009-2012.
- [6] Немцева Н.Г., Пржонский А.М. // Химия высоких энергий. 1982. Т. 16. № 2. С. 172-175.
- [7] Немцева Н.Г., Пржонский А.М. // Химия высоких энергий. 1990. Т. 24. № 1. С. 76-79.
- [8] Радциг А.А., Смирнов Б.М. Справочник по атомной и молекулярной физике. М.: Атомиздат, 1980. 240 с.
- [9] Kline L.E. et al. // J. Appl. Phys. 1979. V. 50. N 11. P. 6789.
- [10] Смирнов Б.М. Отрицательные ионы. М.: Атомиздат, 1978. 176 с.
- [11] Цендин Л.Д. // ЖТФ. 1989. Т. 59. В. 1. С. 21-28.

Киевский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко

Поступило в Редакцию
5 апреля 1990 г.

Письма в ЖТФ, том 16, вып. 12

26 июня 1990 г.

07; 12

© 1990

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЯ РАДИАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫХ СВЕТОВЫХ ПОЛЕЙ

В.В. Котляр, В.А. Соферь

Известна функция комплексного пропускания для пространственного фильтра, выполняющего операцию дифференцирования для одномерных световых полей (см., например, [1]). Вид этой функции следует из теоремы о дифференцировании Фурье-преобразования. Если $F(x)$ -Фурье-образ функции $f(\xi)$, то $x F(x)$ -Фурье-образ функции $-i \frac{d}{d\xi} f(\xi)$.

Это означает, что если на входе Фурье-коррелятора (рис. 1) имеется световое поле с комплексной функцией $f(\xi)$, то помещая в частотную плоскость пространственный фильтр с функцией комплексного пропускания

$$\tau(x) = x = |x| e^{i\theta(x)}, \quad (1)$$

$$\text{где } \theta(x) = \begin{cases} 0, & x > 0 \\ \pi, & x \leq 0 \end{cases},$$